








	<h2 style="color: #E67E22;">IRFIBE30G</h2>
 <small>YIC International Co., Limited.</small>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRFIBE30G
	<b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 800V 2.1A TO220FP
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRFIBE30G.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 13273 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	IRFIBE30G
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 2.1A TO220FP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	13273 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 2.1A (Tc) 35W (Tc) Through Hole TO-
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	35W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 Ohm @ 1.3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	78nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1300pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS non-compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	*IRFIBE30G

IRFIBE30G ist neu im Original, Suche IRFIBE30G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRFIBE30G Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage IRFIBE30G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>IRFIBF20G</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 900V 1.2A TO220FP	 <b>IRFIBE20G</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 800V 1.4A TO220FP	 <b>IRFIBE30GPBF</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 800V 2.1A TO220FP	 <b>IRFIBE30GPBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 2.1A TO220FP
 <b>IRFIBC44LC</b> IR IRFIBC44LC IR	 <b>IRFIBE30G-103</b> VB IRFIBE30G-103 VB	 <b>IRFIBE20GPBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 1.4A TO220FP	 <b>IRFIBE20G</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 800V 1.4A TO220FP

### heiße Teile

Mehr

IRFIB7N50LPBF	IRFIB8N50K	IRFIB8N50K	IRFIB9N60A	IRFIBC20G
IRFIBC20G	IRFIBC20GPBF	IRFIBC20GPBF	IRFIBC30	IRFIBC30G
IRFIBC30G	IRFIBC30GPBF	IRFIBC30GPBF	IRFIBC40G	IRFIBC40G
IRFIBC40GLC	IRFIBC40GLC	IRFIBC40GLCPBF	IRFIBC40GLCPBF	IRFIBC40GPBF
IRFIBC40GPBF	IRFIBE20G	IRFIBE20G	IRFIBE20GPBF	IRFIBE20GPBF
IRFIBE30G	IRFIBE30G-103	IRFIBE30GPBF	IRFIBE30GPBF	IRFIBF30G
IRFIBF30G	IRFIBF30GPBF	IRFIBF30GPBF	IRFIZ14G	IRFIZ14G
IRFIZ14GPBF	IRFIZ14GPBF	IRFIZ24EPBF	IRFIZ24G	IRFIZ24G
IRFIZ24GPBF	IRFIZ24GPBF	IRFIZ24N	IRFIZ24NPBF	IRFIZ34A
IRFIZ34EPBF	IRFIZ34G	IRFIZ34G	IRFIZ34GPBF	IRFIZ34GPBF

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited